

SOT23 NPN SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR

FMMT6517

ISSUE 3 – NOVEMBER 1995

FEATURES

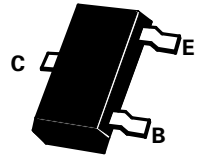
- * 350 Volt V_{CE0}
- * Gain of 15 at $I_C=100\text{mA}$

APPLICATIONS

- * SUITABLE FOR AMPLIFIER AND SWITCHING PRODUCTS

COMPLEMENTARY TYPE - FMMT6520

PARTMARKING DETAIL - 517



SOT23

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	350	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	350	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Continuous Collector Current	I_C	500	mA
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ\text{C}$	P_{tot}	330	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb}=25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Breakdown Voltages	$V_{(BR)CBO}$	350		V	$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$
	$V_{(BR)CEO}$	350		V	$I_C=1\text{mA}, I_B=0^*$
	$V_{(BR)EBO}$	5		V	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$
Cut-Off Currents	I_{CBO}		50	nA	$V_{CB}=250\text{V}, I_E=0$
	I_{EBO}		50	nA	$V_{EB}=5\text{V}, I_C=0$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		0.3	V	$I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}^*$
			0.35	V	$I_C=20\text{mA}, I_B=2\text{mA}^*$
			0.5	V	$I_C=30\text{mA}, I_B=3\text{mA}^*$
			1.0	V	$I_C=50\text{mA}, I_B=5\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		0.80	V	$I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}^*$
			0.85	V	$I_C=20\text{mA}, I_B=2\text{mA}^*$
			0.90	V	$I_C=30\text{mA}, I_B=3\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		2.0	V	$I_C=100\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	20			$I_C=1\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}$
		30			$I_C=10\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}^*$
		30	200		$I_C=30\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}^*$
		20	200		$I_C=50\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}^*$
		15			$I_C=100\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}^*$
Output Capacitance	C_{obo}		6	pF	$V_{CB}=20\text{V}, f=1\text{MHz}$
Transition Frequency	f_T	50		MHz	$I_C=10\text{mA}, V_{CE}=20\text{V}, f=20\text{MHz}$

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9